

<<模拟CMOS集成电路设计>>

图书基本信息

书名：<<模拟CMOS集成电路设计>>

13位ISBN编号：9787560516066

10位ISBN编号：7560516068

出版时间：2003-2

出版时间：西安交通大学出版社

作者：毕查德·拉扎维

页数：562

字数：877000

译者：陈贵灿

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<模拟CMOS集成电路设计>>

### 内容概要

本书介绍模拟CMOS集成电路的分析与设计。

从直观和严密的角度阐述了各种模拟电路的基本原理和概念，同时还阐述了在SOC中模拟电路设计遇到的新问题及电路技术的新发展。

本书由浅入深，理论与实际结合，提供了大量现代工业中的设计实例。

全书共18章。

前10章介绍各种基本模块和运放及其频率响应和噪声。

第11章至第13章介绍带隙基准、开关电容电路以及电路的非线性和失配的影响，第14、15章介绍振荡器和锁相环。

第16章至18章介绍MOS器件的高阶效应及其模型、CMOS制造工艺和混合信号电路的版图与封装。

## <<模拟CMOS集成电路设计>>

### 作者简介

毕查德·拉扎维于1985年在沙里夫理工大学的电气工程系获得理学学士学位，并分别于1988年和1992年在斯坦福大学电气工程系获得理学硕士和博士学位。他曾在AT&T贝尔实验室工作，随后又受聘于Hewlett-Packard实验室，直到1996年为止。1996年9月，他成为加利福尼亚大学洛杉矶分校

## <<模拟CMOS集成电路设计>>

### 书籍目录

作者简介 中文版前言 译者序 致谢 第1章 模拟电路设计绪论 1.1 研究模拟电路的重要性 1.2 研究模拟集成电路的重要性 1.3 研究CMOS模拟集成电路的重要性 1.4 本书的特点 1.5 电路设计的一般概念 习题 第2章 MOS器件物理基础 2.1 基本概念 2.2 MOS的I/V特性 2.3 二级效应 2.4 MOS器件模型 习题 第3章 单级放大器 3.1 基本概念 3.2 共源级 3.3 源跟随器 3.4 共栅级 3.5 共源共栅级 3.6 器件模型的选择 习题 第4章 差动放大器 4.1 单端与差动的工作方式 4.2 基本差动对 4.3 共模响应 4.4 MOS为负载的差动对 4.5 吉尔伯特单元 习题 第5章 无源与有源电流镜 5.1 基本电流镜 5.2 共源共栅电源镜 5.3 有源电流镜 习题 第6章 放大器的频率特性 第7章 噪声 第8章 反馈 第9章 运算放大器 第10章 稳定性与频率补偿 第11章 带隙基准 第12章 开关电容电路 第13章 非线性与不匹配 第14章 振荡器 第15章 锁相环 第16章 短沟道效应与器件模型 第17章 CMOS工艺技术 第18章 版图与封装 英汉词汇对照

## <<模拟CMOS集成电路设计>>

### 媒体关注与评论

本书是加州大学洛杉矶分校（UCLA）的新教材。  
该书组织严谨，内容丰富，循序渐进。  
在阐述原理和概念时，由浅入深，逐步分析。  
模拟电路设计需要直观、严密和创新。  
在阐述各种模拟电路的改进和新电路结构的产生时，着重观察和分析，不断地提出问题和解决问题，重视这三方面能力的培养。

## <<模拟CMOS集成电路设计>>

### 编辑推荐

《模拟CMOS集成电路设计》是加州大学洛杉矶分校（UCLA）的新教材。

该书组织严谨，内容丰富，循序渐进。

在阐述原理和概念时，由浅入深，逐步分析。

模拟电路设计需要直观、严密和创新。

在阐述各种模拟电路的改进和新电路结构的产生时，着重观察和分析，不断地提出问题和解决问题，重视这三方面能力的培养。

<<模拟CMOS集成电路设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>